

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Б1.В.ДВ.04.01 Элементная база электронных устройств

**Направление подготовки (специальность) 35.04.06 Агроинженерия
Профиль образовательной программы Электротехнологии и электрооборудова-
ние в сельском хозяйстве
Форма обучения очная**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация самостоятельной работы	3
2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов	3
3. Методические рекомендации по подготовке к занятиям	20

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		подготовка курсового проекта (работы)	подготовка реферата/эссе	индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	самостоятельно изучение вопросов (СИВ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные сведения по физике полупроводников	-	-	-	3	1
2	Контактные явления				3	1
3	Полупроводниковые диоды	-	-	-	3	1
4	Биполярные транзисторы	-	-	-	3	1
5	Тиристоры	-	-	-	3	1
6	Полевые транзисторы	-	-	-	3	1
7	Оптоэлектронные приборы	-	-	-	3	0,5
8	Интегральные микросхемы	-	-	-	3	0,5

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ

2.1 Физические основы полупроводниковой электроники.

Полупроводниковая электроника на дискретных (отдельных) компонентах содержит ряд вариантов выполнения усилительного каскада на транзисторе с ОЭ. Принцип действия усилительных каскадов с ОЭ рассмотрим на примере наиболее распространенной схемы (рис. 1). На входе каскада действуют усиливаемые переменные ток i_{ex} и напряжение u_{ex} , а на выходе – усиленные переменные ток i_h и напряжение u_{hix} .

В этой схеме усилительного каскада конденсаторы C_1 и C_2 – разделительные. Конденсатор C_1 препятствует протеканию постоянного тока от источника питания E_k в цепь источника входного сигнала. Конденсатор C_2 обеспечивает выделение из коллекторного напряжения переменной составляющей, поступающей на резистор нагрузки R_h . Резисторы базового делителя напряжения R_1 , R_2 задают *режим покоя* транзистора, при котором в нем протекают только постоянные токи покоя базы I_{Bp} , коллектора I_{Kp} и эмиттера, а на его базе, коллекторе и эмиттере соответственно действуют постоянные I_{Ep} напряжения покоя U_{Bp} , U_{Kp} , U_{Ep} .

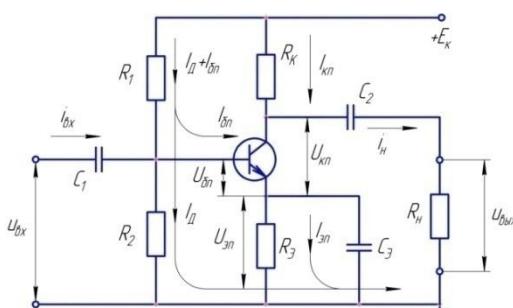


Рис. 1. Схема усилительного каскада с ОЭ

Резистор R_3 и делитель R_1, R_2 составляют цепь отрицательной обратной связи (ООС), предназначенную для стабилизации режима покоя транзистора при изменении его температуры (для термостабилизации). Действие обратной связи объясняется следующим образом. При увеличении, например, из-за роста температуры тока коллектора покоя $I_{KП}$ возрастают ток эмиттера покоя $I_{ЭП}$ и падение напряжения на резисторе R_3 , поскольку $U_{ЭП} = I_{ЭП} R_3$. Так как напряжение между базой и землей (база – земля) $U_{Б3}$ фиксировано базовым делителем R_1, R_2 и $U_{Б3} = U_{БП} + U_{ЭП}$, то с увеличением напряжения $U_{ЭП}$ уменьшает напряжение $U_{БП}$. Это приводит к призакрыванию транзистора, уменьшению тока базы покоя $I_{БП}$ и, следовательно, снижению тока коллектора покоя $I_{KП}$. Тем самым производится компенсация первоначального увеличения тока коллектора покоя.

Включение резистора R_3 в цепь эмиттера изменяет работу каскада и при усилении переменного сигнала. Переменный ток эмиттера создает на резисторе R_3 падение напряжения $u_3 = i_3 R_3$, которое уменьшает усиливаемое напряжение, подводимое к базе транзистора, ведь $u_{Б3} = u_{БХ} - u_3$. При этом снижается и коэффициент усиления каскада, поскольку действует ООС по переменному току. Для ее исключения резистор R_3 шунтируют конденсатором C_2 достаточно большой емкости. Поскольку сопротивление конденсатора мало, то переменный ток протекает по нему и не создает падения напряжения на резисторе R_3 .

В режиме покоя транзистора расчет параметров каскада по постоянному току (т.е. при отключенном входном сигнале) проводят графоаналитическим методом с использованием статических выходных и входных ВАХ транзистора (рис. 7). Этот метод очень нагляден и удобен при нахождении связи параметров режима покоя каскада ($U_{KП}$ и $I_{KП}$) с амплитудными значениями его переменных составляющих – выходного напряжения $U_{выхт}$ и коллекторного тока $I_{Kт}$.

При расчетах каскада с ОЭ на выходных характеристиках транзистора (рис. 2, а) проводят линию нагрузки по постоянному току (линия 1-2), положение которой определяется вторым законом Кирхгофа для коллекторной цепи каскада:

$$E_K = U_{KП} + I_{KП}(R_K + R_3)$$

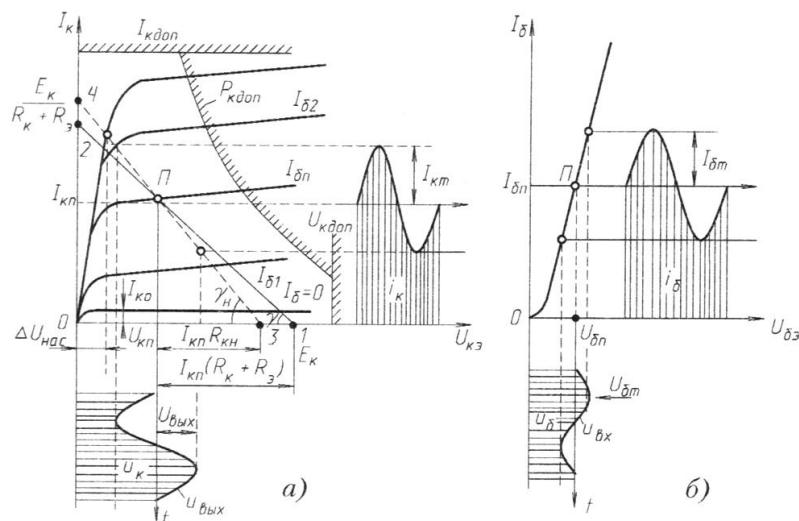


Рис. 2. Графический анализ работы каскада с ОЭ с помощью выходных (а) и входных (б) характеристик

Данную линию можно провести из точки E_K под углом $\gamma = \arcctg(R_K + R_3)$, на практике же ее строят по двум точкам, характеризующим режимы холостого хода (точка 1) и короткого замыкания (точка 2) в коллекторной цепи транзистора. Для точки 1: ток и

напряжение холостого хода $I_{KX}=0$, $U_{KX}=E_K$; для точки 2: напряжение и ток короткого замыкания $U_{K3}=0$, $I_{K3}=E_K/(R_K+R_s)$.

При расчетах любые значения тока I_{KP} и напряжения U_{KP} определяются точками пересечения (*рабочими точками*) выходных характеристик с линией нагрузки по постоянному току. Одна из этих точек, полученная для заданного тока базы покоя I_{Bp} , называется точкой покоя и обозначается буквой П (в некоторых источниках А или О). Используя координаты точки покоя П, можно определить ток коллектора покоя I_{Kp} , напряжение коллектора покоя U_{Kp} и падение напряжения на резисторе R_K , равное $U_{RK}=I_{Kp}R_K$. Отметим, что транзистор работает в этом случае в активном режиме.

Для определения параметров выходного сигнала в динамическом режиме усиления (с подключенными входным сигналом и нагрузкой) используют линию нагрузки по переменному току (динамическую линию нагрузки). Если учесть, что сопротивление источника питания E_K и конденсатора C_2 по переменному току малы, то сопротивление нагрузки по переменному току будет определяться параллельно включенными резисторами R_K и R_H :

$$R_{KH} = \frac{R_K R_H}{R_K + R_H}$$

Поскольку в режиме усиления входного сигнала токи и напряжения транзистора состоят из суммы постоянных и переменных составляющих, то линия нагрузки по переменному току тоже пройдет через точку покоя П. И поскольку $R_{KH} < R_K$, то линия будет находиться под углом $\gamma_h = \arccos R_{KH}$, большим, чем угол γ . Для ее построения на оси абсцисс отмечают точку 3, где формально напряжение равно сумме $U_{KP} + I_{KP}R_{KH}$, и через нее и точку П проводят прямую (пунктирная линия 3-4 на рис. 7, а).

С целью упрощения расчетов принцип действия каскада с ОЭ рассмотрим при отключенной нагрузке R_H (*режим холостого хода по переменному току*). При подаче на вход каскада переменного напряжения u_{ex} переменный ток базы i_B будет изменяться в соответствии с входной характеристикой (рис. 2, б). Одновременно с этим и по такому же закону станет менять свои значения переменный ток коллектора. Так, например, при увеличении амплитуды входного напряжения возрастает ток базы i_B . Поскольку ток коллектора $i_K = h_{21}i_B$ (h_{21} составляет 50...75), то он тоже возрастет. В результате увеличивается падение переменного напряжения на резисторе R_K (ведь $U_{RK} = i_{Kp}R_K$), а переменное напряжение на коллекторе $u_{KE} = u_{vex} = E_K - i_K R_K$ уменьшается. При уменьшении же входного напряжения картина меняется на обратную. Из проведенного анализа следует, что каскад с ОЭ наряду с усилением мощности изменяет фазу входного сигнала на 180°.

Точно таким же образом работает схема и при подключении нагрузки R_H , однако переменный коллекторный ток при этом распределяется между резисторами R_K и R_H , что естественно снижает усиление.

При использовании каскада с ОЭ для усиления мощности необходимо учитывать параметры *предельно допустимых режимов* работы транзистора. Таких параметров три и они строятся на выходных характеристиках. Кривая допустимой мощности рассеяния строится по формуле $P_{k,don} = U_{K3}I_k$ и представляет собой гиперболу, а линии допустимых коллекторного тока $I_{k,don}$ и напряжения коллектор-эмиттер $U_{k,don}$ – прямые, параллельные осям координат.

В целях исключения искажений формы выходного сигнала необходимо обеспечить такой режим работы транзистора, чтобы рабочая точка, перемещаясь по линии нагрузки, не выходила за пределы *напряжения насыщения* ($\Delta U_{nas} = 0,3 \dots 0,7$ В).

Усилительный каскад с ОЭ:

- позволяет получить наиболее высокий коэффициент усиления по напряжению (десятки единиц) и большой коэффициент усиления по току (десятки единиц);
- имеет невысокое входное (несколько сотен ом – десятков килоом) и относительно большое входное сопротивления (от нескольких до сотен килоом);

- имеет более узкий диапазон частот, в котором обеспечивается равномерное усиление, по сравнению с усилительным каскадом с ОБ;
- вносит фазовый сдвиг 180° в диапазоне средних (рабочих) частот.

2.2 Физические свойства и виды проводимости полупроводников. Р-п переход (электронно-дырочный переход) и его свойства.

Электрический переход в полупроводнике — это граничный слой между двумя областями, физические характеристики которых существенно различаются.

Переходы между двумя областями полупроводника с различным типом электропроводности называют электронно-дырочными или р-п-переходами.

Переходы между двумя областями с одним типом электропроводности (*n*- или *p*-типов), отличающиеся концентрацией примесей и соответственно значением удельной проводимости, называют электронно-электронными (*n*⁺ - *n*⁻-переход) или дырочно-дырочными (*p*⁺ - *p*⁻-переход), причем знак «+» в обозначении одного из слоев показывает, что концентрация носителей заряда одного типа в этом слое значительно выше, чем во втором, и поэтому слой имеет меньшее удельное электрическое сопротивление.

Переходы между двумя полупроводниковыми материалами, имеющими различную ширину запрещенной зоны, называют гетеропереходами. Если одна из областей, образующих переход, является металлом, то такой переход называют переходом металл — полупроводник.

Электрические переходы нельзя создать путем механического контакта двух областей с разными физическими свойствами, хотя при рассмотрении физических процессов такая абстракция обычно используется. Это объясняется тем, что поверхности кристаллов обычно загрязнены оксидами и атомами других веществ. Существенную роль играет воздушный зазор, устранить который при механическом контакте практически невозможно.

Полупроводниковым диодом называется полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом, имеющим два вывода.

Структура полупроводникового диода с электронно-дырочным переходом и его условное графическое обозначение приведены на рис. 1.



Рис. 1. Схема структуры полупроводникового диода (a) и его графическое обозначение (б)

Буквами *p* и *n* обозначены слои полупроводника с проводимостями соответственно *p*-типа и *n*-типа. В контактирующих слоях полупроводника имеет место диффузия дырок из слоя *p* в слой *n*, причиной которой является то, что их концентрация в слое *p* значительно больше их концентрации в слое *n*. В итоге в приграничных областях слоя *p* и слоя *n* возникает так называемый обедненный слой, в котором мала концентрация подвижных носителей заряда (электронов и дырок). Обедненный слой имеет большое удельное сопротивление. Ионы примесей обедненного слоя не компенсированы дырками или электронами. В совокупности ионы образуют некомпенсированные объемные заряды, создающие электрическое поле с напряженностью *E*. Это поле препятствует переходу дырок из слоя *p* в слой *n* и переходу электронов из слоя *n* в слой *p*. Оно создает так называемый дрейфовый поток подвижных носителей заряда, перемещающий дырки из

слоя n в слой p и электроны из слоя p в слой n . Таким образом, в зависимости от полярности проходящего через диод тока, проводимость диода существенно изменяется, приводя к изменению величины проходящего тока.

Основные характеристики полупроводникового диода представляются его вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Вольт-амперная характеристика – это зависимость тока i , протекающего через диод, от напряжения u , приложенного к диоду. Вольт-амперной характеристикой называют и график этой зависимости (рис. 2).

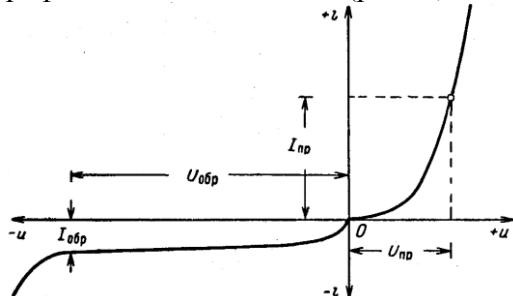


Рис. 2. Вольт-амперная характеристика и основные параметры полупроводникового диода

Фотодиод представляет собой пластинку полупроводникового материала, внутри которого имеются области примесной электронной (n – область) и дырочной (p – область) проводимостей. Границу между этими областями называют контактным $p-n$ переходом (рис. 3). Электронная и дырочная области снабжены невыпрямляющими контактами с присоединенными к ним выводами, с помощью которых осуществляется связь с внешней цепью. С целью предохранения чувствительного слоя фотодиода от воздействия внешней среды он покрывается лаком или монтируется в герметичном корпусе, изготовленном или из металла (со стеклянным входным окном) или из пластмасс.

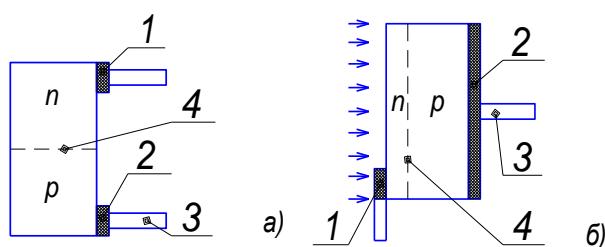


Рис. 3. Принципиальная схема фотодиода.

- а) – направление светового пучка параллельно плоскости $p-n$ перехода;
 - б) – световой пучок и плоскость $p-n$ перехода взаимно перпендикулярны.
- 1 – контакт n – области; 2 – контакт p – области; 3 – выводы; 4 – $p-n$ переход.

2.3 Структура и основные элементы. Вольт-амперная характеристика диода при инжекции и экстракции носителей заряда. Расчет распределения неосновных носителей заряда в базе диода.

Внешнее напряжение нарушает динамическое равновесие токов в $p-n$ -переходе. $P-n$ -переход переходит в неравновесное состояние. В зависимости от полярности напряжения приложенного к областям в $p-n$ -перехода возможно два режима работы.

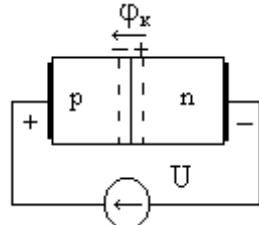


Рис. 1

1) **Прямое смещение p - n перехода.** P - n -переход считается смещённым в прямом направлении, если положительный полюс источника питания подсоединен к p -области, а отрицательный к n -области (рис.1)

При прямом смещении, напряжения j_k и U направлены встречно, результирующее напряжение на p - n -переходе убывает до величины $j_k - U$. Это приводит к тому, что напряженность электрического поля убывает и возобновляется процесс диффузии основных носителей заряда. Кроме того, прямое смещение уменьшает ширину p -перехода, т.к. $l_{p-n} \approx (j_k - U)^{1/2}$. Ток диффузии, ток основных носителей заряда, становится много больше дрейфового. Через p - n -переход протекает прямой ток

$$I_{p-n} = I_{np} = I_{\text{диф}} + I_{dp}.$$

При протекании прямого тока основные носители заряда p -области переходят в n -область, где становятся неосновными. Диффузионный процесс введения основных носителей заряда в область, где они становятся неосновными, называется *инжекцией*, а прямой ток – диффузионным током или током инжекции. Для компенсации неосновных носителей заряда накапливающихся в p и n -областях во внешней цепи возникает электронный ток от источника напряжения, т.е. принцип электронейтральности сохраняется. При увеличении U ток резко возрастает, $I_{np} = I_0 e^{\frac{U}{\varphi_T}}$, φ_T – температурный потенциал, и может достигать больших величин т.к. связан с основными носителями концентрация которых велика.

2) **Обратное смещение**, возникает когда к p -области приложен минус, а к n -области плюс, внешнего источника напряжения (рис.2).

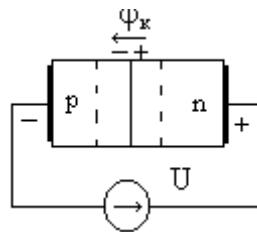


Рис. 2

Такое внешнее напряжение U включено согласно j_k . Оно: увеличивает высоту потенциального барьера до величины $j_k + U$; напряженность электрического поля возрастает; ширина p - n перехода возрастает, т.к. $l_{p-n} \approx (j_k + U)^{1/2}$; процесс диффузии полностью прекращается и через p - n переход протекает дрейфовый ток, ток неосновных носителей заряда. Такой ток p - n -перехода называют обратным, а поскольку он связан с неосновными носителями заряда, которые возникают за счет термогенерации то его называют тепловым током и обозначают $-I_0$, т.е.

$$I_{p-n} = I_{obp} = I_{\text{диф}} + I_{dp} \quad I_{dp} = I_0.$$

Этот ток мал по величине т.к. связан с неосновными носителями заряда, концентрация которых мала. Таким образом, p - n перехода обладает односторонней проводимостью.

При обратном смещении концентрация неосновных носителей заряда на границе перехода несколько снижается по сравнению с равновесной. Это приводит к диффузии неосновных носителей заряда из глубины p и n -областей к границе p - n перехода. Достигнув ее неосновные носители попадают в сильное электрическое поле и переносятся через p - n переход, где становятся основными носителями заряда. Диффузия неосновных носителей заряда к границе p - n перехода и дрейф через него в область, где они становятся основными носителями заряда, называется *экстракцией*. Экстракция и создает обратный ток p - n перехода – это ток неосновных носителей заряда.

Величина обратного тока сильно зависит: от температуры окружающей среды, материала полупроводника и площади $p-n$ перехода.

Температурная зависимость обратного тока определяется выражением $I_0(T) = I_0(T_0) 2^{\frac{T-T_0}{T^*}}$, где T_0 - номинальная температура, T - фактическая температура, T^* - температура удвоения теплового тока $T^* = \begin{cases} 5-6^\circ C, Si \\ 8-10^\circ C, Ge \end{cases}$.

Тепловой ток кремниевого перехода много меньше теплового тока перехода на основе германия $I_0(T_0) \ll I_0(T_0)$ (на 3-4 порядка). Это связано с j_k материала.

- С увеличением площади перехода возрастает его объем, а следовательно возрастает число неосновных носителей появляющихся в результате термогенерации и тепловой ток.

- Итак, главное свойство $p-n$ -перехода – это его односторонняя проводимость.

Основным для решения поставленной задачи является уравнение непрерывности, например, для дырок в базе диода с электропроводностью p -типа $\nabla = \frac{1}{L} \frac{dN}{dx}$.

Таково распределение постоянной составляющей избыточной концентрации неосновных носителей заряда в базе диода при разных напряжениях.

2.4 Физический смысл параметров диода. Виды пробоев диода. Процессы в диодах при больших прямых токах. Переходные процессы в диодах.

Под пробоем $p-n$ -перехода понимают значительное уменьшение обратного сопротивления, сопровождающееся возрастанием обратного тока при увеличении приложенного напряжения. Различают три вида пробоя: туннельный, лавинный и тепловой.

В основе туннельного пробоя лежит туннельный эффект, т. е. «просачивание» электронов сквозь потенциальный барьер, высота которого больше, чем энергия носителей заряда.

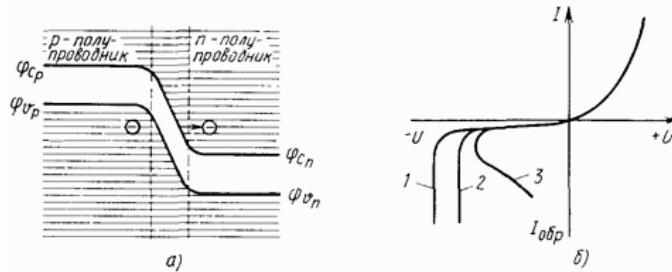


Рис. 1. Энергетическая зонная диаграмма, поясняющая туннельный переход электрона (а); вольт-амперная характеристика $p-n$ -перехода (б): 1 - лавинный пробой; 2 - туннельный пробой; 3 - тепловой пробой

Иными словами, туннельный пробой наступает тогда, когда напряженность электрического поля возрастает настолько, что становится возможным туннельный переход электронов из валентной зоны полупроводника с электропроводностью одного типа в зону проводимости полупроводника с электропроводностью другого типа (рис. 1, а). Туннельный пробой чаще всего возникает у полупроводниковых приборов, имеющих узкий переход и малое значение удельного сопротивления, причем напряженность электрического поля должна быть достаточно высокой (более 105 В/см). При такой напряженности энергетические зоны искривляются настолько, что энергия электронов валентной зоны полупроводника p -типа становится такой же, как и энергия свободных электронов зоны проводимости полупроводника n -типа. В результате перехода электронов «по горизонтали» из области p в область n возникает туннельный ток. Начало туннельного пробоя оценивается по

десятикратному превышению туннельного тока над обратным. При увеличении температуры напряжение, при котором возникает туннельный пробой, уменьшается.

Лавинный пробой вызывается ударной ионизацией, которая происходит тогда, когда напряженность электрического поля, вызванная обратным напряжением, достаточно велика. Неосновные носители заряда, движущиеся через р-п-переход, ускоряются настолько, что при соударении с атомами в зоне р-п-перехода ионизируют их. В результате появляется пара электрон — дырка. Вновь появившиеся носители заряда ускоряются электрическим полем и в свою очередь могут вызвать ионизацию следующего атома и т. д. Если процесс ударной ионизации идет лавинообразно, то по тому же закону увеличиваются количество носителей заряда и обратный ток. При лавинной ионизации ток в цепи ограничен только внешним сопротивлением. Для количественной характеристики этого процесса используется коэффициент лавинного умножения, который показывает, во сколько раз ток, протекающий через переход, больше обратного тока:

Коэффициент можно определить из эмпирического выражения

$$M_n = \frac{1}{1 - (U/U_{\text{проб лав}})^n},$$

2.5 Структура и основные режимы работы. Распределение стационарных потоков носителей заряда. Постоянные токи при активном режиме. Явления в транзисторах при больших токах.

Статической характеристикой называют зависимость тока электрода транзистора от одного из аргументов при фиксированном значении другого и медленном уменьшении варьируемых величин, при котором режим работы практически сохраняется статически. Каждая точка такой характеристики соответствует определенному статическому режиму транзистора.

Входными характеристиками транзисторов в схеме с ОБ представляют собой зависимость вида:

$$I_o = f(U_{\text{об}}) \text{ при } U_{\text{кб}} = \text{const.}$$

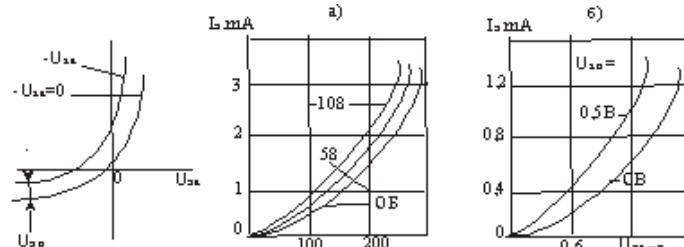


Рис. 1 Входные характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ: а) германиевых типа МП -14 маломощных; б) кремниевых типа 2Т – 925 мощных

Выходные характеристики в данной схеме включения транзистора (ОБ) определяются зависимостью вида (рис. 2).

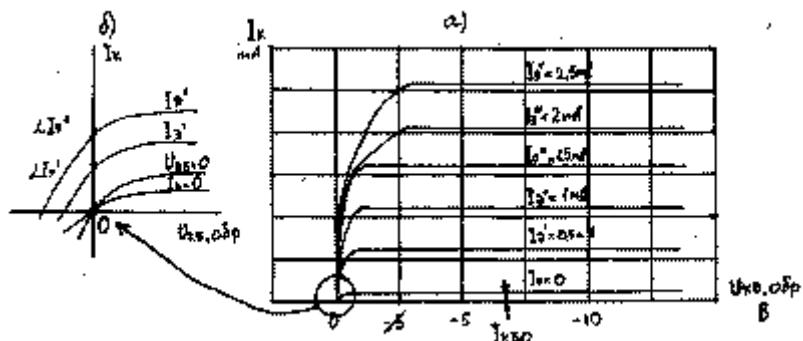


Рис. 2 Выходные характеристики биполярного транзистора типа МП-14 в схеме с ОБ: а) общий вид; б) начальный участок характеристики

Постоянные токи, протекающие через транзистор, являются нелинейными функциями приложенных напряжений. Но, если на постоянные составляющие накладываются переменные сигналы с амплитудами малыми по сравнению со значениями постоянных составляющих, между переменным входным напряжением и переменным выходным током будет существовать линейная зависимость, и работа транзистора будет иметь линейный характер.

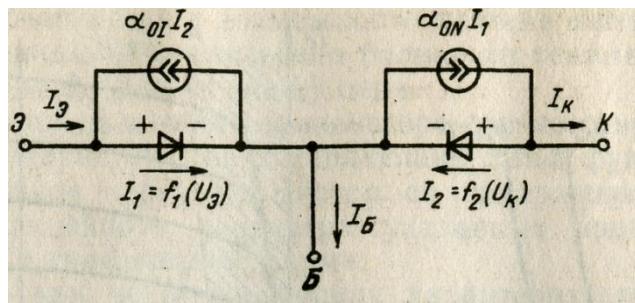


Рис.3 Эквивалентная схема транзистора в виде модели Эберса-Молла (Эквивалентная схема биполярного транзистора на постоянном токе)

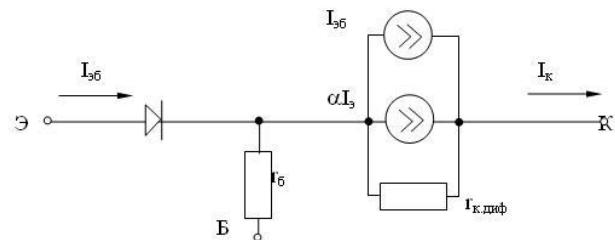


Рис. 4 Эквивалентная схема транзистора по постоянному току, включенного по схеме с ОБ

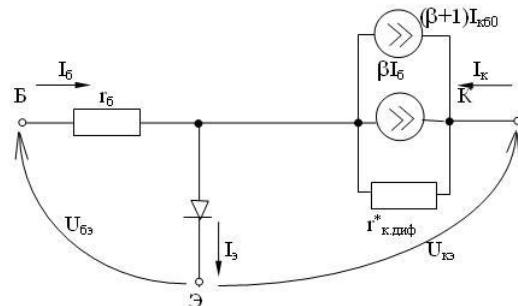


Рис. 5 Эквивалентная схема транзистора по постоянному току, включенного по схеме с ОЭ

Частотная характеристика – зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты входящего сигнала. С повышением частоты, способность транзистора усиливать сигнал постепенно падает. Причиной тому являются паразитные емкости, образовавшиеся в PN-переходах. На изменения входного сигнала в базе транзистор реагирует не мгновенно, а с определенным замедлением, обусловленным затратой времени на

наполнение зарядом этих емкостей. Поэтому, при очень высоких частотах, транзистор просто не успевает среагировать и полностью усилить сигнал.

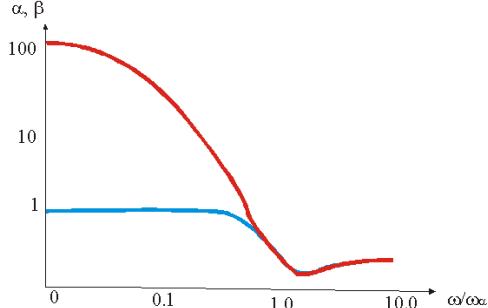


Рис. 6 Частотная зависимость модуля коэффициентов передачи по току в схеме ОБ - α и ОЭ - β .

Биполярные транзисторы широко используются в цифровой технике в качестве электронных ключей. В этих устройствах используются сигналы в виде почти прямоугольных (трапецидальных) импульсов большой амплитуды. В общем случае для описания работы транзистора в импульсном (ключевом) режиме необходимо использовать нелинейные динамические модели транзистора (например, динамические компьютерные модели Эберса - Молла). Однако в большинстве случаев ограничиваются расчетом амплитуды и длительности фронтов импульсных сигналов.

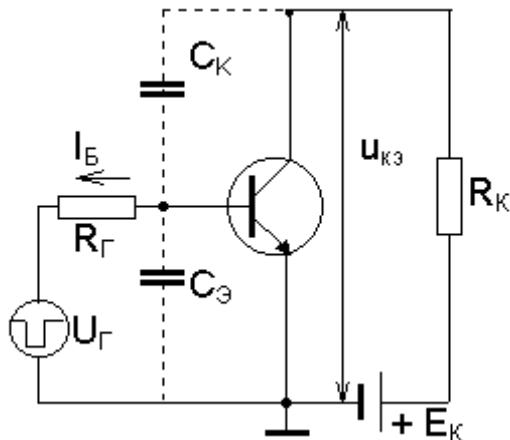


Рис. 7 Схема транзисторного ключа на биполярном транзисторе

Катастрофические отказы связаны с полной потерей работоспособности прибора и происходят в результате обрывов или коротких замыканий внутренних или внешних выводов, пробоя р-п-перехода, трещин стекла. Они обусловлены главным образом недостатками конструкции или нарушением технологического процесса. Катастрофические отказы не являются основными для транзисторов - на их долю приходится примерно 20 % всех наблюдаемых отказов. В основном же отказы транзисторов обусловлены постепенным изменением параметров сверх допустимых отклонений.

Отказы, вызываемые постепенным изменением основных параметров и выходом их значений за установленные нормы, иногда называются условными отказами. Условность отказа определяется выбором критериев годности. Условно отказавший транзистор может быть фактически вполне работоспособным в таких радиоэлектронных схемах, которые не критичны к изменению параметра в рассматриваемых пределах.

2.6 Статические параметры. Пробой транзистора. Статические характеристики. Эквивалентные схемы. Частотные характеристики. Однопереходные транзисторы.

Физические причины, вызывающие пробой переходов транзистора, те же, что и в полупроводниковом диоде. В то же время пробой переходов в транзисторах имеет определенную специфику, связанную с взаимодействием переходов и проявляющуюся главным образом в схеме с общим эмиттером, где напряжение $u_{K\bar{E}}$ прикладывается к обоим переходам. В схеме ОБ напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода $U_{K\bar{B}0}$ проб близко к напряжению пробоя изолированного перехода. Эмиттерный переход, как правило, работает при прямом смещении и его пробивное напряжение не представляет интереса, однако следует иметь в виду, что из-за сильного легирования эмиттера напряжение пробоя эмиттерного перехода мало - несколько вольт. В схеме ОЭ условия возникновения лавинного пробоя очень сильно зависят от режима базовой цепи. В случае, когда ток базы не ограничен пробой коллекторного перехода происходит так же, как и в схеме ОБ, и возникает при том же пробивном напряжении на коллекторе $U_{K\bar{B}0}$ проб. При фиксированном токе базы, когда базовая цепь питается от источника тока, проявляется механизм положительной обратной связи, снижающей пробивное напряжение. Его суть состоит в том, что образующиеся в переходе в результате ударной ионизации пары носителей заряда разделяются полем перехода: электроны уходят на коллектор, увеличивая его ток, а дырки скапливаются в базе, увеличивая ее потенциал и снижая потенциальный барьер в эмиттерном переходе. В результате увеличивается инжекция электронов из эмиттера в базу и растет коллекторный ток. Соответственно уменьшается пробивное напряжение. Наиболее сильно накопление дырок в базе происходит при отсутствии базового тока ($i_B=0$), что соответствует разомкнутой цепи базы. В этом режиме пробивное напряжение $U_{K\bar{E}0}$ проб оказывается в несколько раз ниже, чем в схеме ОБ, и определяется выражением:

$$U_{K\bar{E}0\text{ проб}} = U_{K\bar{B}0\text{ проб}} \sqrt[b]{1 - \alpha} \quad (1)$$

где $b=2\ldots 6$ - коэффициент, зависящий от материала, из которого изготовлен транзистор. В связи с сильным уменьшением пробивного напряжения запрещается эксплуатация транзистора с разомкнутой базовой цепью.

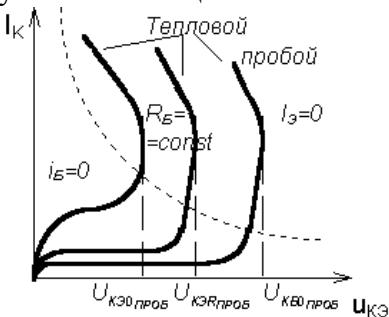


Рис. 1

На рис. 1 приведены выходные характеристики транзистора в режиме пробоя. Помимо рассмотренных выше пробивных напряжений $U_{K\bar{B}0\text{ проб}}$ и $U_{K\bar{E}0\text{ проб}}$ на рисунке показано напряжение $U_{K\bar{E}R0\text{ проб}}$, соответствующее некоторому конкретному сопротивлению R_B , включенному в цепь базы и определяющему ее ток. Из рисунка видно, что $U_{K\bar{E}0\text{ проб}} < U_{K\bar{E}R0\text{ проб}} < U_{K\bar{B}0\text{ проб}}$. Для увеличения напряжения пробоя коллекторного перехода степень легирования коллектора стараются выбирать достаточно низкой. Так же, как и в полупроводниковом диоде, обратимый лавинный пробой (называемый иногда первичным пробоем) при отсутствии ограничения тока может перейти в тепловой пробой (вторичный пробой), характеризующийся уменьшением напряжения $u_{K\bar{E}}$ (см. рис. 3.29) и приводящий к выходу транзистора из строя. При этом в транзисторе опасность возникновения теплового пробоя оказывается значительно сильнее, чем в диоде. Это

объясняется тем, что за счет инжекции электронов из эмиттера в базу через обратно-смещенный коллекторный переход при больших напряжениях протекает большой обратный ток и, соответственно, велика мощность, рассеиваемая в переходе. Термовой пробой наступает в том случае, когда рассеиваемая на коллекторе мощность $P_K = i_{K\phi} \times i_K$ превышает максимально допустимую рассеиваемую мощность $P_K \text{ макс}$. Гипербола, соответствующая допустимой мощности, показана пунктиром на рис. 3.29. Кроме лавинного и термового пробоя в транзисторах с очень узкой базой возникает специфический для транзисторной структуры вид пробоя, называемый эффектом смыкания. Он связан с эффектом Эрли и заключается в том, что при очень большом обратном напряжении коллекторный переход, расширяясь, заполняет всю базовую область и смыкается с эмиттерным переходом, что эквивалентно их короткому замыканию.

Однопереходный транзистор или, как его еще называют, двухбазовый диод, представляет собой трехэлектродный полупроводниковый прибор с одним p-n переходом. Структура его условно показана на рис. 2, а, условное графическое обозначение в схемах — на рис. 2, б.

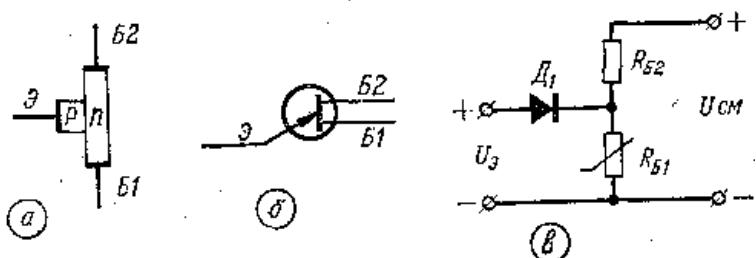


Рис. 2

Основой однопереходного транзистора является кристалл полупроводника (например, с проводимостью n-типа), называемый базой. На концах кристалла имеются омические контакты Б1 и Б3, между которыми расположена область, имеющая выпрямляющий контакт с полупроводником p-типа, выполняющим роль эмиттера.

Принцип действия однопереходного транзистора удобно рассмотреть, пользуясь простейшей эквивалентной схемой (рис. 2, в), где R_{B1} и R_{B2} — сопротивления между соответствующими выводами базы и эмиттером, а $D1$ — эмиттерный p-n переход. Ток, протекающий через сопротивления R_{B1} и R_{B2} , создает на первом из них падение напряжения, смещающее диод $D1$ в обратном направлении. Если напряжение на эмиттере U_3 меньше падения напряжения на сопротивлении R_{B1} , диод $D1$ закрыт, и через него течет только ток утечки. Когда же напряжение U_3 становится выше напряжения на сопротивлении R_{B1} , диод начинает пропускать ток в прямом направлении. При этом сопротивление R_{B1} уменьшается, что приводит к увеличению тока в цепи $D1 R_{B1}$, а это, в свою очередь, вызывает дальнейшее уменьшение сопротивления R_{B1} . Этот процесс протекает лавинообразно. Сопротивление R_{B1} уменьшается быстрее, чем увеличивается ток через p-n переход, в результате на вольт-амперной характеристике однопереходного транзистора (рис. 3), появляется область отрицательного сопротивления (кривая 1). При дальнейшем увеличении тока зависимость сопротивления R_{B1} от тока через p-n переход уменьшается, и при значениях, больших некоторой величины (I_{выкл}) оно не зависит от тока (область насыщения).

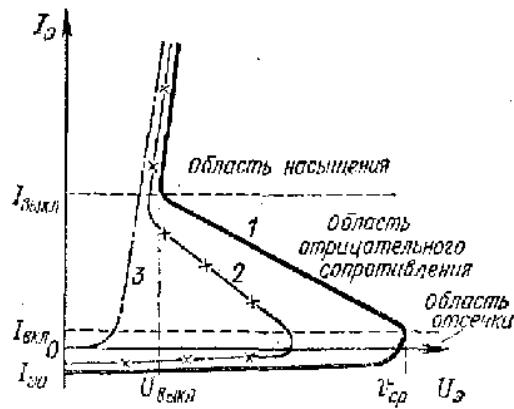


Рис. 3

При уменьшении напряжения смещения U_{cm} вольт-амперная характеристика смещается влево (кривая 2) и при отсутствии его обращается в характеристику открытого р-п перехода (кривая 3).

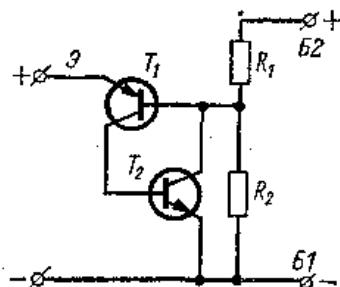


Рис. 4

Здесь ток, протекающий через делитель, состоящий из резисторов R_1 и R_2 , создает на втором из них падение напряжения, закрывающее эмиттерный переход транзистора T_1 . При увеличении напряжения на эмиттере транзистор T_1 начинает пропускать ток в базу транзистора T_2 , в результате чего он также открывается. Это приводит к снижению напряжения на базе транзистора T_1 , что, в свою очередь, вызывает еще большее открывание его и т. д. Другими словами, процесс открывания транзисторов в таком устройстве также протекает лавинообразно и вольтамперная характеристика устройства имеет вид, аналогичный характеристике однопереходного транзистора.

2.7 Полевые транзисторы с управляющим переходом. Эквивалентные схемы полевого транзистора с управляющим переходом. Частотные свойства полевых транзисторов. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Параметры и свойства полевых транзисторов.

Полевой транзистор с управляющим р-п- переходом – это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала р-п-переходом, смещенным в обратном направлении.

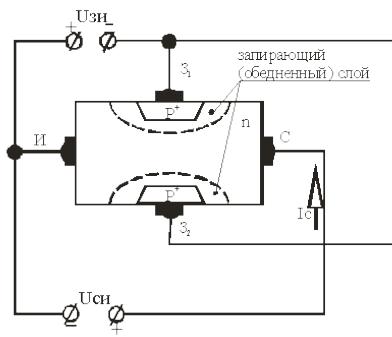


Рис. 1 – Устройство полевого транзистора с управляемым р-п-переходом (каналом п- типа)



Рис. 2 – Условное обозначение полевого транзистора с р-п-переходом и каналом п- типа (а), каналом р- типа (б)

Каналом полевого транзистора называют область в полупроводнике, в которой ток основных носителей заряда регулируется изменением ее поперечного сечения.

Электрод (вывод), через который в канал входят основные носители заряда, называют истоком. Электрод, через который из канала уходят основные носители заряда, называют стоком. Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала за счет управляющего напряжения, называют затвором.

Как правило, выпускаются кремниевые полевые транзисторы. Кремний применяется потому, что ток затвора, т.е. обратный ток р-п- перехода, получается во много раз меньше, чем у германия.

Условные обозначения полевых транзисторов с каналом п- и р- типов приведены на рис. 2.

Полярность внешних напряжений, подводимых к транзистору, показана на рис. 1. Управляющее (входное) напряжение подается между затвором и истоком. Напряжение U_{zi} является обратным для обоих р-п- переходов. Ширина р-п- переходов, а, следовательно, эффективная площадь поперечного сечения канала, его сопротивление и ток в канале зависят от этого напряжения. С его ростом расширяются р-п- переходы, уменьшается площадь сечения токопроводящего канала, увеличивается его сопротивление, а, следовательно, уменьшается ток в канале. Следовательно, если между истоком и стоком включить источник напряжения U_{ci} , то силой тока стока I_c , протекающего через канал, можно управлять путем изменения сопротивления (сечения) канала с помощью напряжения, подаваемого на затвор. На этом принципе и основана работа полевого транзистора с управляемым р-п- переходом.

При напряжении $U_{zi} = 0$ сечение канала наибольшее, его сопротивление наименьшее и ток I_c получается наибольшим.

Ток стока I_c нач при $U_{zi} = 0$ называют начальным током стока.

Напряжение U_{zi} , при котором канал полностью перекрывается, а ток стока I_c становится весьма малым (десятые доли микроампер), называют напряжением отсечки U_{zi} отс.

Частотные свойства полевых транзисторов определяются постоянной времени RC -цепи затвора. Поскольку входная емкость C_{zi} у транзисторов с р-п- переходом велика (десятки пикофарад), их применение в усилительных каскадах с

большим входным сопротивлением возможно в диапазоне частот, не превышающих сотен килогерц – единиц мегагерц.

При работе в переключающих схемах скорость переключения полностью определяется постоянной времени RC-цепи затвора. У полевых транзисторов с изолированным затвором входная емкость значительно меньше, поэтому их частотные свойства намного лучше, чем у полевых транзисторов с р-п-переходом.

Ток насыщения I_{c0} в цепи стока транзистора, включённого по схеме с общим истоком, при затворе накоротко замкнутым с истоком (т. е. при $U_{3..i}=0$) - характерен лишь для полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом.

Ток стока в рабочей точке можно определить по следующей формуле:

$$I_c = I_{c0}(1-U_{3..i}/U_{otc})^2 \quad (1)$$

где U_{otc} - напряжение отсечки.

Уравнение (1) является приближенным для характеристики передачи любого полевого транзистора (особенно с малыми напряжениями отсечки).

Напряжение отсечки U_{otc} - один из основных параметров, характеризующих полевой транзистор. При напряжении на затворе, численно равном напряжению отсечки, практически полностью перекрывается канал полевого транзистора, и ток стока при этом стремится к нулю.

Измерение истинного значения напряжения отсечки (при полном перекрытии канала) произвести довольно трудно, так как при этом приходится иметь дело с чрезвычайно малыми токами стока, к тому же зависящими от сопротивления изоляции. В справочных данных на полевые транзисторы всегда указывается, при каком значении тока стока произведены измерения напряжения отсечки. Так, например, для транзисторов КП102 напряжения U_{otc} получены при токе стока 20 мА, а у транзистора КП103 - при токе стока 10 мА.

Крутизна проходной характеристики. Входное сопротивление полевых транзисторов со стороны управляющего электрода составляет 10^7 - 10^9 Ом для транзисторов с р-п-переходом. Так как входные токи полевых транзисторов чрезвычайно малы, то управление током в выходной цепи осуществляется входным напряжением. Поэтому усиительные свойства полевого транзистора, как и электронных ламп, целесообразно характеризовать крутизной проходной характеристики.

Крутизна полевых транзисторов

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{3..i}} \text{ при } U_{c..i} = \text{const.}$$

Максимальное значение крутизны характеристики S_{\max} достигается при $U_{3..i}=0$. При этом численное значение S_{\max} равно проводимости канала полевого транзистора при нулевых смещениях на его электродах.

Крутизна характеристики полевых транзисторов на 1-2 порядка меньше, чем у биполярных транзисторов, поэтому при малых сопротивлениях нагрузки коэффициент усиления каскада на полевом транзисторе меньше коэффициента усиления аналогичного каскада на биполярном транзисторе.

В большинстве случаев крутизу характеристики полевых транзисторов считают частотно-независимым параметром. Поэтому быстродействие электронных схем на полевых транзисторах ограничено в основном паразитными параметрами схемы.

Выражение для крутизны характеристики в рабочей точке ПТ получим, используя (1):

$$S = S_{\max} (1 - U_{3..i}/U_{otc}), \quad (2)$$

где $U_{3..i}$ - напряжение затвор-исток, при котором вычисляется S ;

$$S_{\max} = 2 \frac{I_{c0}}{U_{otc}} \quad (3)$$

Соотношение (3) позволяет по двум известным параметрам рассчитать третий.

Пробивное напряжение. Механизм пробоя полевого транзистора можно объяснить возникновением лавинного процесса в переходе затвор - канал. Обратное напряжение диода затвор - канал изменяется вдоль длины затвора, достигая максимального значения у стокового конца канала. Именно здесь происходит пробой полевого транзистора. Если выводы стока и истока поменять местами, то пробивное напряжение почти не изменится. Например, у транзистора КП102 пробой наступает при суммарном напряжении между затвором и стоком, равном 30 В. Это напряжение является минимальным; фактически напряжение пробоя составляет в среднем около 55 В, а у отдельных экземпляров достигает 120 В.

Пробой не приводит к выходу из строя ПТ с управляющим р-п-переходом, если при этом рассеиваемая мощность не превышает допустимой. После пробоя в нормальном рабочем режиме эти транзисторы восстанавливают свою работоспособность. Это свойство транзисторов с р-п-переходом даёт им известное преимущество перед МОП-транзисторами, у которых пробой однозначно приводит к выходу прибора из строя.

Однако необходимо оговориться, что и для ПТ с р-п-переходом пробой не всегда безвреден. Степень его влияния на параметры транзистора определяется значением и продолжительностью действия тока, протекающего при этом через затвор. Так, в результате пробоя может увеличиться ток утечки затвора в нормальном режиме.

Динамическое сопротивление канала r_k определяется выражением

$$r_k = \frac{\Delta U_c}{\Delta I_{\text{с.и}}} \text{ при } U_{\text{з.и}} = \text{const}$$

Это сопротивление при $U_{\text{с.и}} = 0$ и произвольном смещении $U_{\text{з.и}}$ можно выразить через параметры транзистора:

$$r_k = \frac{U_{\text{отс}}}{2I_{\text{с.и}}(1 - U_{\text{з.и}}/U_{\text{отс}})} \quad (4)$$

При малом напряжении сток-исток вблизи начала координат ПТ ведёт себя как переменное омическое сопротивление, зависящее от напряжения на затворе. Это остаётся справедливым даже в случае изменения полярности напряжения стока; необходимо только, чтобы напряжение на затворе было больше, чем на стоке.

2.8 Диодные тиристоры. Диодный тиристор с зашунтизованным эмиттерным переходом. Триодные тиристоры. Тиристоры, проводящие в обратном направлении. Симметричные тиристоры. Способы управления тиристорами. Конструкция и технология изготовления тиристоров.

Переключение тиристора из закрытого состояния в открытое происходит при возрастании суммарного дифференциального коэффициента передачи тока до единицы. В то же время в каждой из транзисторных структур, составляющих тиристор, коэффициенты передачи тока эмиттера могут быть близки к единице уже при малых напряжениях и токах, т.е. $\frac{U_{\text{вкл}}}{U_{\text{вн}}}$ в простейшей динисторной структуре мало. Для уменьшения начального значения коэффициента передачи одну из базовых областей всех тиристоров делают относительно толстой (до 200 мкм) по сравнению с диффузионной длиной неосновных носителей.

Для уменьшения коэффициента передачи тока эмиттера другого транзистора его эмиттерный переход шунтируют объемным сопротивлением прилегающей базовой области (рис. 1). Такое шунтирование осуществляют путем нанесения одного из основных электродов (например, катода) не только на эмиттерную область, но и частично на поверхность прилегающей базовой области.

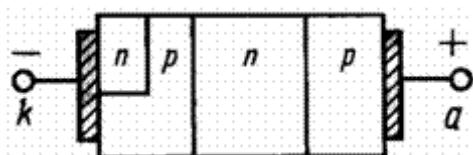


Рис.1

Шунтирование обеспечивает малые значения коэффициента передачи тока при малых напряжениях на тиристоре, так как почти весь ток при этом проходит по шунтирующему сопротивлению базы, минуя левый (рис. 1) эмиттерный переход в связи с его относительно большим сопротивлением при малых напряжениях. При больших напряжениях на тиристоре сопротивление левого эмиттерного перехода становится меньше шунтирующего сопротивления базы. Это значит, что теперь почти весь ток будет проходить через эмиттерный переход и будет вызван инжекцией неосновных носителей заряда в прилегающую базовую область.

Шунтирование, во-первых, дает возможность создавать тиристоры с большими значениями напряжения включения; во-вторых, при шунтировании эмиттерного перехода получается более резкая зависимость коэффициента передачи тока от напряжения и от тока. Поэтому тиристор с зашунтизованным эмиттерным переходом будет иметь так называемую жесткую характеристику переключения, т.е. будет переходить из закрытого в открытое состояние каждый раз при одном и том же напряжении включения. При слабой зависимости коэффициента передачи тока от напряжения и от тока открывание тиристора может происходить в некотором диапазоне значений напряжения включения, т.е. тиристор в этом случае будет иметь так называемую мягкую характеристику переключения.

Симметричные тиристоры (симисторы) изготовлены на основе пятислойной кремниевой структуры (рис. 2) и предназначены для работы в коммутационной и регулирующей аппаратуре (светорегуляторы для ламп накаливания, коммутаторы нагрузок, аппараты импульсной сварки, регуляторы температуры для бытовых электроприборов, стабилизаторы тока и напряжения, мощные ультразвуковые генераторы и т. п.). Симистор способен проводить ток в обоих направлениях, заменяя таким образом два встречно-параллельно включенных триисторов. Иными словами, у симистора нет постоянных анода и катода.

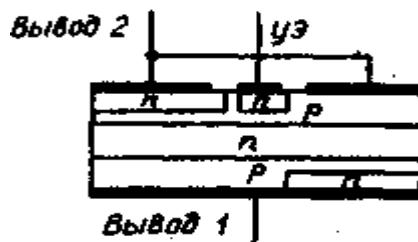


Рис. 2.

Для определенности принято выводы симистора, включаемые в цепь нагрузки, обозначать цифрами 1 и 2. Если между выводами 1 и 2 симистора приложено рабочее напряжение, а открывающий импульс на управляющий электрод не подан, то симистор закрыт и тока не проводит. Включают (открывают) симистор подачей на управляющий электрод импульса тока относительно вывода 2.

2.9 Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов.
Полупроводниковые приборы отображения информации и инфракрасные излучающие диоды. Фоторезисторы. Фотодиоды. Полупроводниковые фотоэлементы. Фототранзисторы и фототиристоры. Оптопары и оптоэлектронные микросхемы.

Фотодиоды – селективные регистрирующие фотоэлектрические ПЛЭ, основанные на явлении фотовольтаического эффекта в полупроводниковом контактном переходе и предназначенные как для работы с приложением внешнего напряжения, так и без него.

Фотовольтаическим эффектом – (фотогальваническим, вентильным) – называют форму внутреннего фотоэффекта в полупроводниках со свойствами, неоднородными для движения photoносителей даже при отсутствии внешнего напряжения, при которой оптически генерированные неравновесные носители заряда пространственно разделяются в объеме полупроводника вследствие его неоднородности, образуя при этом пространственно разделенные объемные заряды и, следовательно, разность потенциалов между участками облученного образца, называемую фото ЭДС (V_F).

Фотодиод представляет собой пластинку полупроводникового материала, внутри которого имеются области примесной электронной (n – область) и дырочной (p – область) проводимостей. Границу между этими областями называют контактным $p-n$ переходом (рис. 1). Электронная и дырочная области снабжены невыпрямляющими контактами с присоединенными к ним выводами, с помощью которых осуществляется связь с внешней цепью. С целью предохранения чувствительного слоя фотодиода от воздействия внешней среды он покрывается лаком или монтируется в герметичном корпусе, изготовленном или из металла (со стеклянным входным окном) или из пластмасс.

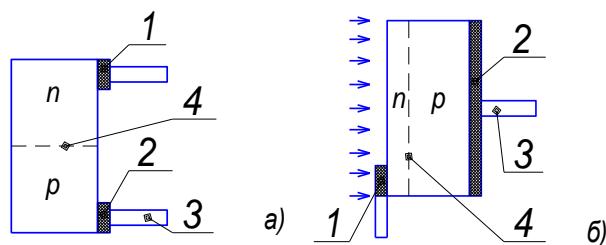


Рис. 1. Принципиальная схема фотодиода.

- а) – направление светового пучка параллельно плоскости $p-n$ перехода;
 б) – световой пучок и плоскость $p-n$ перехода взаимно перпендикулярны.
 1 – контакт n – области; 2 – контакт p – области; 3 – выводы; 4 – $p-n$ переход.

Оптоэлектронными называют приборы, которые чувствительны к электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях, а также приборы, производящие или использующие такое излучение.

Излучение в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях относят к оптическому диапазону спектра. Обычно к указанному диапазону относят электромагнитные волны с длиной от 1 нм до 1 мм, что соответствует частотам примерно от $0,5 \cdot 10^{12}$ Гц до $5 \cdot 10^{17}$ Гц. Иногда говорят о более узком диапазоне частот – от 10 нм до 0,1 мм ($\sim 5 \cdot 10^{12} \dots 5 \cdot 10^{16}$ Гц). Видимому диапазону соответствуют длины волн от 0,38 мкм до 0,78 мкм (частота около 10^{15} Гц).

На практике широко используются источники излучения (излучатели), приемники излучения (фотоприемники) и оптры (оптопары).

Оптром называют прибор, в котором имеется и источник, и приемник излучения, конструктивно объединенные и помещенные в один корпус.

Из источников излучения нашли широкое применение светодиоды и лазеры, а из приемников – фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы и фототиристоры.

Широко используются оптры, в которых применяются пары светодиод-фотодиод, светодиод-фототранзистор, светодиод-фототиристор.

Основные достоинства оптоэлектронных приборов:

- высокая информационная емкость оптических каналов передачи информации, что является следствием больших значений используемых частот;
- полная гальваническая развязка источника и приемника излучения;
- отсутствие влияния приемника излучения на источник (однонаправленность потока информации);

- невосприимчивость оптических сигналов к электромагнитным полям (высокая помехозащищенность).

Оптрон – полупроводниковый прибор, содержащий источник излучения и приемник излучения, объединенных в одном корпусе и связанные между собой оптически, электрически и одновременно обеими связями. Очень широко распространены оптраны, у которых в качестве приемника излучения используются фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и фототиристор.

В резисторных оптранах выходное сопротивление при изменении режима входной цепи может изменяться в $10^7 \dots 10^8$ раз. Кроме того, вольт-амперная характеристика фоторезистора отличается высокой линейностью и симметричностью, что обуславливает широкую применимость резистивных оптопар в аналоговых устройствах. Недостатком резисторных оптранов является низкое быстродействие – 0,01…1 с.

В цепях передачи цифровых информационных сигналов применяются главным образом диодные и транзисторные оптраны, а для оптической коммутации высоковольтных сильноточных цепей – тиристорные оптраны. Быстродействие тиристорных и транзисторных оптранов характеризуется временем переключения, которое часто лежит в диапазоне 5…50 мкс.

Рассмотрим подробнее оптопару светодиод-фотодиод (рис. 2, а). Излучающий диод (слева) должен быть включен в прямом направлении, а фотодиод – в прямом (режим фотогенератора) или обратном направлении (режим фотопреобразователя). Направления токов и напряжений диодов оптопары приведены на рис. 2, б.

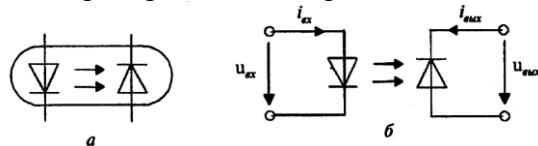


Рис. 2. Схема оптопары (а) и направление токов и напряжений в ней (б)

Изобразим зависимость тока $i_{вых}$ от тока $i_{вх}$ при $u_{вых}=0$ для оптопары АОД107А (рис. 2). Указанная оптопара предназначена для работы как в фотогенераторном, так и в фотопреобразовательном режиме.

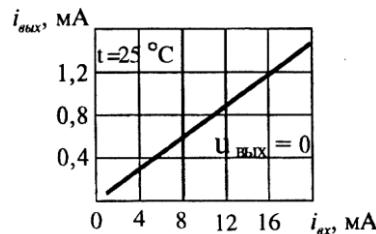


Рис. 3. Передаточная характеристика оптопары АОД107А

Фототранзистор и фототиристор

Выходные характеристики фототранзистора подобны выходным характеристикам обычного биполярного транзистора, в котором положение характеристик определяется не током базы, а уровнем освещенности (или величиной светового потока).

Свойства фототиристора подобны свойствам обычного тиристора, однако с той лишь особенностью, что включение тиристора осуществляется не с помощью импульса тока управления, а с помощью светового импульса.

2.10 Пассивные элементы интегральных микросхем. Биполярные транзисторы в ИМС. Диоды полупроводниковых ИМС.

В интегральных микросхемах процесс формирования активных элементов (транзисторов, диодов), пассивных элементов (резисторов, конденсаторов) и

соединительных элементов происходит на поверхности или в объеме полупроводникового кристалла или на поверхности диэлектрической подложки в едином технологическом цикле. Минимальное количество внутрисхемных соединений дает возможность резко повысить надежность микроэлектронной аппаратуры.

Для изоляции областей соседних биполярных транзисторов можно использовать обратно смещенный (закрытый) $p-n$ переход. В типовой структуре вертикальных транзисторов n^+-p-n типа наряду с основным образуется паразитный транзистор $p-n-p$, включающий области база – коллектор – подложка основной структуры (рис. 1, а). Это учитывается в его модели, включающей наряду с основным (вертикальным) транзистором также паразитный транзистор и изолирующую диодную цепь (рис. 1, б).

Выполненная с высокой степенью легирования эмиттерная область (обозначена n^+), обладает поверхностным сопротивлением 2...3 Ом/см (сопротивление квадрата из плоского проводника фиксированной толщины). Поверхностное сопротивление базового p -слоя составляет примерно 100...200 Ом/см. Коллекторная область имеет значение удельного сопротивления 0,5...1,0 Ом \times см и может образовывать выпрямляющий контакт с алюминием. Для получения омического контакта внутри нее формируют область n^+ .

Основным недостатком приведенной структуры является сравнительно большие токи обратно смещенного изолирующего перехода. Применяется также биполярная структура с диэлектрической изоляцией. Транзисторы формируют в изолированных карманах, окруженных тонким слоем диэлектрика (окиси кремния). Это обеспечивает высокое качество изоляции, т. к. обратный ток $p-n$ перехода на несколько порядков превышает ток через диэлектрик, но существенно усложняет технологический процесс и уменьшает плотность элементов на кристалле. Распространенным способом разделения биполярных транзисторов в ИМС служит совмещение рассмотренных способов, называемое изопланарной технологией. При этом изоляция коллекторной области от подложки в горизонтальной плоскости осуществляется закрытым $p-n$ переходом и с боковых сторон в вертикальной плоскости формируются островки диэлектрика.

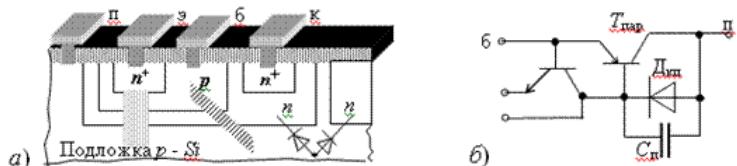


Рис. 1. Структура БТ с изоляцией $p-n$ переходом (а) и его эквивалентная схема (б)

Биполярные ИМС преимущественно проектируют на основе транзисторов типа n^+-p-n , имеющих хорошие усиительные параметры. При необходимости применения транзисторов типа $p-n-p$ их можно получить на базе имеющейся структуры с использованием подложки в качестве коллектора. Такой транзистор имеет невысокие усиительные и частотные параметры. Если требуется одновременно иметь транзисторы с близкими параметрами, т.е. комплементарную пару, то транзистор типа $p-n-p$ формируют в изолированном кармане, и структура получается достаточно сложной. Для реализации логических и других элементов в интегральной технологии разработаны уникальные структуры многоэмиттерных и многоколлекторных транзисторов, элементов с инжекционным питанием, которые не имеют аналогов в виде отдельных приборов.

Полупроводниковые диоды. Для упрощения технологического цикла диоды изготавливают на основе транзисторных структур. Для быстродействующих диодов используют эмиттерный переход при соединенном с базой коллекторе (рис. 2, а). Для диодов, которые должны иметь большое пробивное напряжение, используют коллекторный переход, а эмиттер соединяют с базой (рис. 2, б). Во втором случае скорость

переключения получается в десятки раз ниже из-за большего значения неравновесного заряда, накапливающегося не только в области базы, но и в области коллектора, а также из-за большей емкости перехода.

Рис. 2

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ

№ п.п.	Наименование темы занятия	Объем, академические часы
ПЗ-1	Методы формирования и классификации электронно-дырочных переходов	2
ПЗ-2	Аналитический расчет плавного электронно-дырочного перехода	2
ПЗ-3	Расчет распределения неосновных носителей заряда в базе диода	2
ПЗ-4	Расчет переменных токов и полной проводимости диода	2
ПЗ-5	Расчет вольт-амперной характеристики диода	2
ПЗ-6	Принцип выбора полупроводникового диода	2
ПЗ-7	Статические параметры и характеристики биполярных транзисторов	2
ПЗ-8	Эквивалентные схемы биполярных транзисторов	2
ПЗ-9	Диодный и триодный тиристоры	2
ПЗ-10	Симметричные тиристоры	2
ПЗ-11	Способы управления тиристорами	2
ПЗ-12	Расчет выходных статических характеристик полевого транзистора	2
ПЗ-13	Эквивалентные схемы полевого транзистора	2
ПЗ-14	Полевые транзисторы с изолированным затвором	2
ПЗ-15	Светодиоды и принцип их выбора	2
ПЗ-16	Оптопары и оптоэлектронные микросхемы	2
ПЗ-17	Задачи и принципы микроэлектроники	2
Итого по дисциплине		34

3.1 Практическое занятие №1 (ПЗ-1) Методы формирования и классификации электронно-дырочных переходов.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- уяснить принцип формирования электронно-дырочного перехода и процессы, его сопровождающие;
- понимать различие между гетерогенным переходом и гомогенным переходом;
- понимать влияние воздействия внешних факторов на собственную проводимость полупроводника;

- влияние донорной и акцепторной примесей на характер полупроводника и его работу в электронно-дырочном переходе.

3.2 Практическое занятие №2 (ПЗ-2) Аналитический расчет плавного электронно-дырочного перехода.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.3 Практическое занятие №3 (ПЗ-3) Расчет распределения неосновных носителей заряда в базе диода.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.4 Практическое занятие №4 (ПЗ-4) Расчет переменных токов и полной проводимости диода.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.5 Практическое занятие №5 (ПЗ-5) Расчет вольт-амперной характеристики диода

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- используя аналитическое выражение для вольт-амперной характеристики диода уметь построить ее для различного типа диодов;
- проанализировать вольт-амперную характеристику и отметить основные характерные точки на ней.

3.6 Практическое занятие №6 (ПЗ-6) Принцип выбора полупроводникового диода.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- понимать значения основных параметров полупроводниковых диодов и уметь использовать их для выбора диодов для конкретных устройств и схем.

3.7 Практическое занятие №7 (ПЗ-7) Статические параметры и характеристики биполярных транзисторов.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.8 Практическое занятие №8 (ПЗ-8) Эквивалентные схемы биполярных транзисторов.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.9 Практическое занятие №9 (ПЗ-9) Диодный и триодный тиристоры.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- уяснить структуру полупроводникового динистора;
- понимать принцип его работы и уметь объяснить вид его вольт-амперной характеристики;
- уяснить структуру полупроводникового триодного тиристора;
- понимать принцип работы тиристора и уметь объяснить вид его вольт-амперной характеристики.

3.10 Практическое занятие №10 (ПЗ-10) Симметричные тиристоры.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.11 Практическое занятие №11 (ПЗ-11) Способы управления тиристорами

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- понимать процессы, проходящие в тиристоре при его работе;
- иметь представление об основных схемах управления тиристорами;
- понимать отличие между не запираемым и запираемым тиристорами.

3.12 Практическое занятие №12 (ПЗ-12) Расчет выходных статических характеристик полевого транзистора.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.13 Практическое занятие №13 (ПЗ-13) Эквивалентные схемы полевого транзистора.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.14 Практическое занятие №14 (ПЗ-14) Полевые транзисторы с изолированным затвором.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.

3.15 Практическое занятие №15 (ПЗ-15) Светодиоды и принцип их выбора

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- понять структуру полупроводникового светодиода;
- знать материалы, используемые при изготовлении светодиодов;
- понимать принцип получения видимого света различных длин волн;
- расчет ограничивающего резистора при включении светодиода.

3.16 Практическое занятие №16 (ПЗ-16) Оптопары и оптоэлектронные микросхемы

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- принцип работы оптопар и основные их виды;
- использование оптопар в схемах управления;
- принципы работы оптоэлектронных микросхем.

3.17 Практическое занятие №17 (ПЗ-17) Задачи и принципы микроэлектроники.

При подготовке к практическому занятию подробно ознакомиться с материалом лекции по данной теме, проработать материал по основной и, при необходимости, по дополнительной литературе. При рассмотрении вопроса уяснить принцип работы представленного типа приборов и устройств на их основе, основные параметры и характеристики. Быть готовым ответить на вопросы преподавателя.